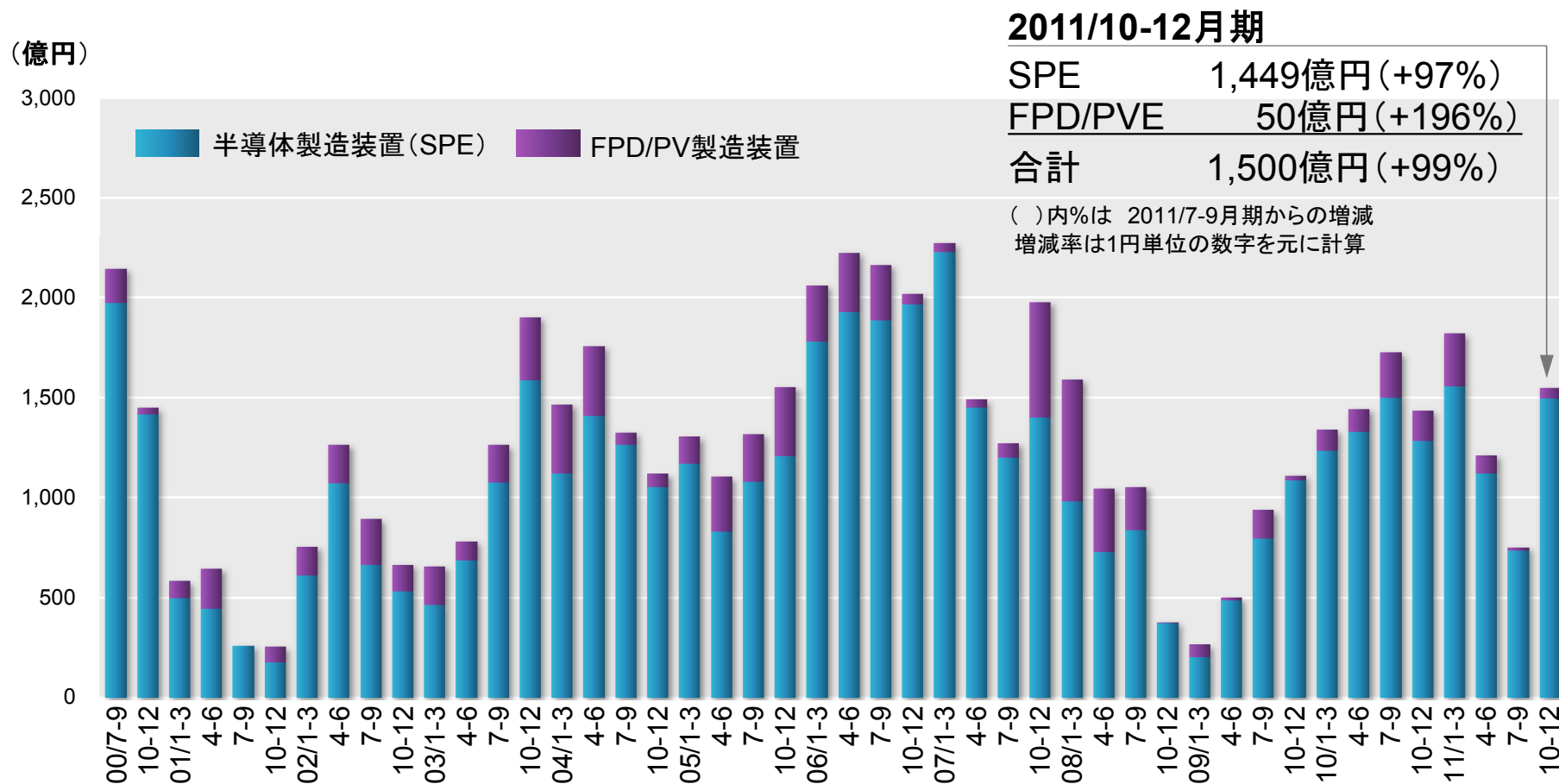


事業概況アップデート

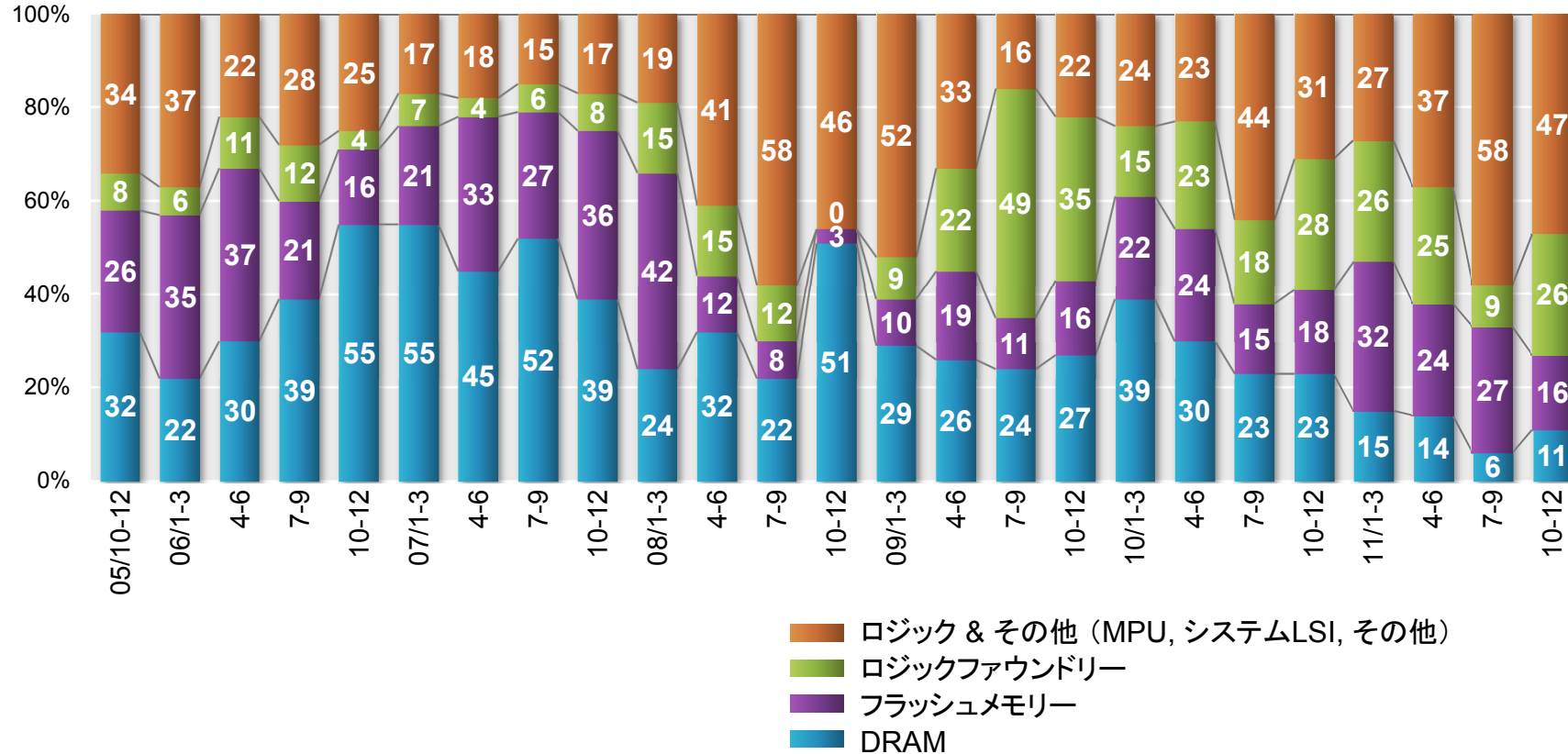
代表取締役社長 竹中 博司

2012年2月3日

四半期 受注額



四半期 アプリケーション別SPE受注



- ロジック & その他 (MPU, システムLSI, その他)
- ロジックファウンドリー
- フラッシュメモリー
- DRAM

グラフは装置本体受注における構成比を示しています

▶ 半導体設備投資

世界経済の減速と不透明感を受け、半導体市況の回復は遅れている。
2012年は、情報端末機器向けを中心とした32/28nmの先端プロセスの採用によるロジック・ファウンドリーの投資は期待されるものの、全体としては前年比10%程度の減少が予想される。

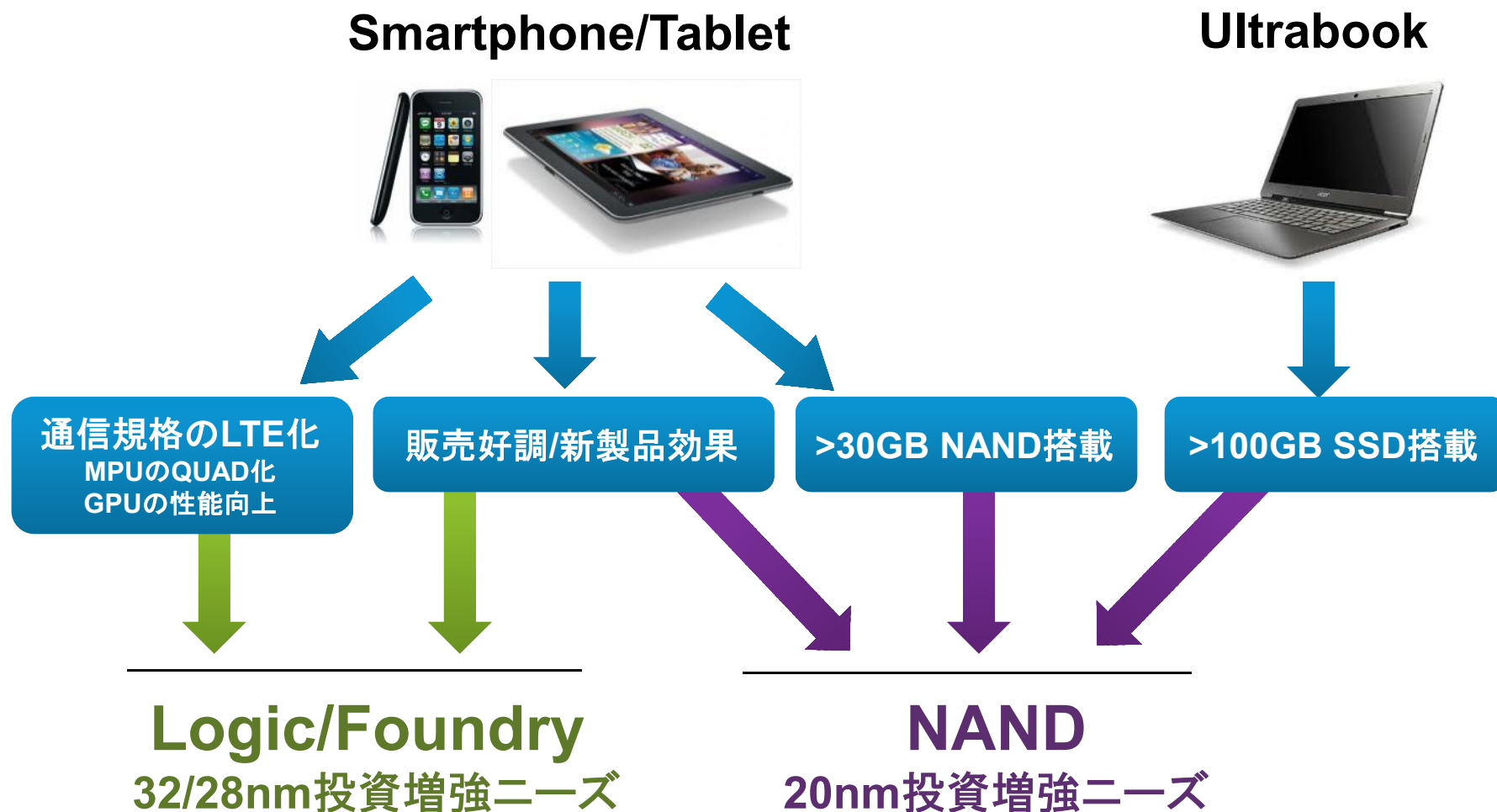
▶ FPD設備投資

中小型パネル向け投資は2011年の反動により、2012年は減少。
大型パネル市場は、TV価格の著しい下落に伴い低迷が続き、2012年の設備投資は前年比半減程度を見込む。
受給バランスの改善は、2013年以降を見込む。

▶ PV設備投資

中長期的には引き続き成長が期待されているが、過剰な生産能力に伴う単価下落により、足元での設備投資は低迷すると予想する。

2012年 情報端末機器が先端投資を牽引



*LTE (Long Term Evolution): 次世代の携帯電話向け高速データ通信規格。現在、世界中の通信業者が導入を予定。

21

次世代デバイスの有力候補 スピントロニクスメモリの製造技術を東北大学と共同開発

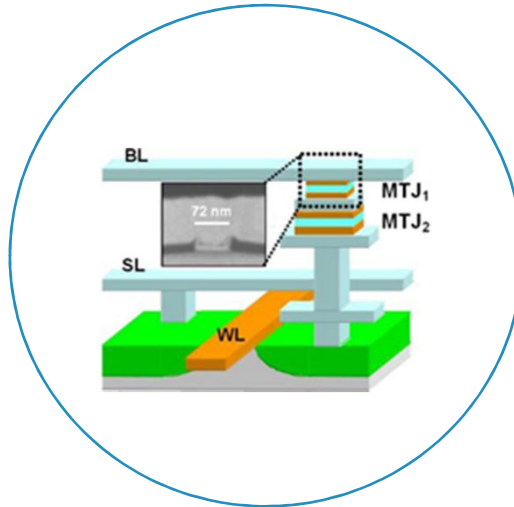
微細化の限界、DRAMに代る新メモリへの期待

スピントロニクスメモリ

スピントロニクスメモリ開発
で世界をリード



磁性材料技術
デバイス技術
設計技術



プロセス技術
装置技術

- 不揮発性メモリ
- 低消費電力で書き込み速度が高速
- 絶縁体を2つの磁性体で挟んだ素子に電流を流し、磁力の向きの違いでデータを記憶する仕組みを持つ

実用化に向けて、量産技術の早期確立を目指す

▶ 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD/PV市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

▶ 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

▶ 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD/PV:フラットパネルディスプレイ及び太陽電池